

第8回ポスター発表展

半導体を中心とする電子デバイスのプロセス技術において、材料表面を清浄化・改質する技術はデバイス界面の信頼性に対して極めて重要である。また、ウェットプロセスを用いた新規なエッチングや薄膜を形成する技術は、デバイスの微細化・三次元化のひとつのテクノロジードライバである。本研究会は界面ナノ現象を明らかにすることでウェットプロセスに関する学問を構築し、次世代へと教育できる環境を整えている。同時に本研究会成果物の実行者である若手の主体性が極めて重要であることから、若手の主体性強化を目的としたポスター発表展を2015年より企画している。若手技術者とベテラン技術者とのFace to Faceの活発な議論を期待して、下記の要項で第8回ポスター展を開催する。あわせて育成ワーキンググループの新たな活動としてチュートリアルを開催する。

若手のポスター発表展 ーベテランとの議論に打ち勝て！ー

- 主催：公益社団法人 応用物理学会 界面ナノ電子化学研究会
- 日時：2023年11月27日(月) 10:25～17:15
- 会場：ナガセ グローバル 人財開発センター(東京都渋谷区千駄ヶ谷)
現地発表のみ

- 開催概要：チュートリアル（育成ワーキンググループ 第0回）
深見一弘 先生「材料表面加工のための電気化学：電位の考え方と使い方」
(京都大学 大学院 工学研究科)

ポスター発表 20件

	開催時間	参加費	定員
チュートリアル	10:25～12:30	2000円(学生無料)	80
ポスター発表	13:30～17:15	2000円(学生無料)	80

参加申込先



- 申込方法：

参加申込先URLもしくはQRコードより、申し込みをお願いします。

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=0672069005389223&EventCode=7144281230

※今年から参加費用のお支払いは、クレジットカードによる事前オンライン決済のみとなります。

(決済には株式会社メタックスペイメントの「イベントペイ」を使用します)

- 申込締切：2023年11月10日(金) 17時 ※定員に限りがあるので早めに参加お申込みください
- ポスター発表展終了後、会場にて第33回カサロス(懇親会)を開催します。(別々に申し込みが必要です。)
- 世話役：
オルガノ 蔦野恭平 tsutano-k@organo.co.jp
日本インテグリス 永渕琢也 takuya.naqafuchi@enteqris.com

第8回ポスター発表展

時刻	内容
10:00～	チュートリアル受付開始
10:25～10:30	開会挨拶：有馬副委員長
10:30～12:30	チュートリアル：深見一弘 先生(京都大学) 「材料表面加工のための電気化学：電位の考え方と使い方」
12:30～13:30	休憩 (昼食は各自準備をお願いします。食事場所は隣の部屋にあります。)

時刻	内容
13:00～	受付
13:30～13:40	開会挨拶：岩元委員長
13:40～14:45	ライトニングトーク
14:45～14:55	休憩（レイアウト変更）
14:55～15:45	ポスターセッション（奇数番号）；10件
15:45～16:35	ポスターセッション（偶数番号）；10件
16:35～16:45	休憩（レイアウト変更）
16:45～16:45	INE活動報告：吉水副委員長
16:55～17:15	表彰式&閉会挨拶：有馬副委員長 集合写真撮影

17:30～19:00 第33回カサロス（懇親会）

（最終退出 19：30）

会場案内 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目8-13

東京メトロ副都心線 北参道駅より徒歩約3分
JR線 代々木駅より徒歩約6分
JR線 千駄ヶ谷駅より徒歩約8分

**駐車場・駐輪場はありません。
公共交通機関をご利用ください。**



第8回ポスター発表展

タイトル	発表者	所属
1 半導体材料向け洗浄水としての機能性水適用事例	岡崎有祐	栗田工業株式会社
2 Wafer on Wafer接合における接合界面の状態と接合進展速度の考察	小池美夏	ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
3 微小グラフェンシートのSTM観察と特異な電子状態分布の考察	李君寰	大阪大学
4 光散乱法を用いた、スラリーの分散性およびウェーハとの相互作用の評価	加藤丈滋	大塚電子株式会社
5 分子動力学法によるアモルファスSiO ₂ 表面への液体分子吸着状態の解析	藤原直澄	株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ
6 PVAローラーブラシノジュールの接触・変形と周囲液体の挙動	鈴木翔大	静岡大学
7 流動場分離法（FFF）を用いた液中パーティクルカウンター（LPC）の性能評価	近藤司	オルガノ株式会社
8 LA-GED-ICP-MSを用いたウェーハエッジの金属不純物の局所分析	榎本葉月	株式会社イアス
9 二流体スプレーの噴射開始時に発生する静電気特性	渡部一哲	愛知工業大学
10 二流体スプレー純水洗浄時に発生するシリコンウェーハ表面電位の変化	伊藤康生	愛知工業大学
11 二流体ジェット噴射面に形成される液膜厚さ分布への液体温度の影響	渡部真将	静岡大学
12 二流体ジェット噴射面における液膜内攪拌効果の検討	土居尚人	静岡大学
13 半導体製造用コンポーネントの新規洗浄剤の開発	清水寿人	東京応化工業株式会社
14 UVと薬液を組み合わせたRuのpost-etch残渣除去	森田康生	株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ
15 狭い領域における均一なウェットエッチング方法	吉田祐希	東京エレクトロン九州株式会社
16 HF/メタノールを用いた酸化膜の等方性ガスエッチングにおける温度、圧力の影響	服部孝司	株式会社日立製作所
17 枚葉式フッ硝酸Siエッチングにおけるウェーハ面内の表面挙動解析	西尾賢哉	ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
18 分布ブラッグ反射鏡で色彩を変化させた逆構造ペロブスカイト太陽電池	五十川裕哉	愛知工業大学
19 nmサイズの狭所内SiO ₂ エッチングにおけるシリコンの疎水性及び表面電位の影響	宮川彰平	株式会社SCREENホールディングス
20 ナノカーボンの触媒作用を援用したGe表面の選択エッチング-エッチング液に添加した酸化剤がエッチング特性に与える影響-	山本聖也	大阪大学

カサロス（懇親会）の詳細ご案内

■主催：応用物理学会 界面ナノ電子化学研究会

■日時：2023年11月27日(月) 17:30~19:00

■参加費：5,500円（学生無料）

■申込方法：参加申込先URLもしくはQRコードより、申し込みをお願いします。

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=0672069005389223&EventCode=6091581197

※今年から参加費用のお支払いは、クレジットカードによる事前オンライン決済のみとなります。

（決済には株式会社メタップスペイメントの「イベントペイ」を使用します）

■申込締切：2023年11月10日(金) 17時

■定員：80名 ※定員に限りがあるので早めに参加お申込みください。

■会場：ナガセ グローバル 人財開発センター(ポスター展と同じ会場になります。)

参加申込先



会場案内



東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目8-13

東京メトロ副都心線 北参道駅より徒歩約3分

JR線 代々木駅より徒歩約6分

JR線 千駄ヶ谷駅より徒歩約8分

東京メトロ 副都心線
北参道駅 1番出口
地上出でから
地下鉄の階段を背にして、
左側後ろの道の坂を上って
徒歩約3分

駐車場・駐輪場はありません。
公共交通機関をご利用ください。